

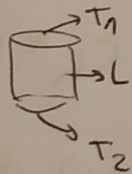
CAPACITOR con dieléctrico
 LA PRESENCIA DE UN MATERIAL DIELECTRICO
 AUMENTA LA CAPACITANCIA DEL CAPACITOR
 Reemplazar ϵ_0 por $\epsilon_0 \epsilon_r$ EN LAS
 ECUACIONES Refleja ESTE EFECTO

a) Suponemos $d \gg b$ para despreciar efectos de borde en el campo. Para calcular el campo generado por la diferencia de potencial aprovechamos la simetría y usamos Gauss: elegimos como superficie cerrada un cilindro de radio r entre a y b y tapas sobre los extremos del capacitor



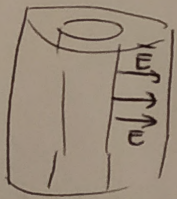
Ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$



$$\Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{T_1} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_{T_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_L \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$= \int_L \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 2\pi r d = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$



$\vec{E} \perp \vec{A}$ campo radial ~~externo~~ ^{radial}

Sólo depende de r , puedo sacar afuera de la integral por que para un dado r va a ser constante

$$\Rightarrow \vec{E}(r) = \frac{Q}{2\pi r d \epsilon_0 \epsilon_r} \hat{r} \text{ [dirección radial]}$$

$$|V| = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r d} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r d} (\ln(b) - \ln(a)) = \frac{Q \ln(b/a)}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r d}$$

C) LA CARGA SE DISTRIBUYE DISTINTO DONDE HAY DIELECTRICO Y DONDE NO.

$$Q_{d-h} = V_2 \cdot C_{d-h} = V_2 \frac{2\pi(d-h)\epsilon_0}{\ln(b/a)}$$

$$Q_h = V_2 C_h = V_2 \frac{2\pi h \epsilon_0 k}{\ln(b/a)}$$

La densidad superficial de carga $\sigma = \frac{Q}{\text{AREA}}$

$$\left[\sigma_{d-h} = \frac{Q_{d-h}}{2\pi a(d-h)} = \frac{V_2 \cdot \epsilon_0}{\ln(b/a) a} = \frac{\epsilon_0 k d V_1}{a \ln\left(\frac{b}{a}\right) (hk + (d-h))} \right]$$

$$\left[\sigma_h = \frac{Q_h}{2\pi a h} = \frac{V_2 \epsilon_0 k}{\ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot a} = \frac{\epsilon_0 k^2 d V_1}{a \ln\left(\frac{b}{a}\right) (hk + (d-h))} \right]$$